

## **Исследование некоторых свойств стеклообразных халькогенидных полупроводников системы Sn–Ge–As–Se**

© Морозов Владимир Александрович

*Кафедра математики и физики. Вятская государственная сельскохозяйственная академия.  
Октябрьский проспект, 133. г. Киров, 610017. Россия. Тел.: (8332) 57-43-72. E-mail: rsm@e-kirov.ru*

**Ключевые слова:** *стеклообразные полупроводники, халькогенидные стекла, плотность, электропроводность, структура.*

### **Аннотация**

Экспериментально исследованы электропроводность, плотность стеклообразных полупроводников системы Sn–Ge–As–Se по разрезам SnSe<sub>2</sub>–GeSe<sub>2</sub>–As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, SnSe–GeSe<sub>2</sub>–As<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, SnSe–GeSe<sub>2</sub>–AsSe, SnSe–GeSe–AsSe. С помощью ЯГР спектроскопии проведено изучение локального окружения и валентного состояния стёкол. Показано, что свойства оловосодержащих халькогенидных стекол определяются содержанием и валентным состоянием олова в их составе.